常壓燒結한 SiC-ZrB2 導電性 複合體의 特性에 미치는 In Situ YAG의 影響

신 용 덕, 주 진 영, <u>고 태 현</u>, 이 정 훈 원광대학교 전기전자 및 정보공학부

Effect of *In Situ* YAG on Properties of the Pressureless-Sintered SiC-ZrB₂ Electroconductive Ceramic Composites

Yong-Deok Shin, Jin-Young Ju, Tae-Hun Ko, Jung-hoon Lee Electrical Electronic and Information Engineering, Wonkwnag Univ.,

Abstract - The effect of content of Al₂O₃+Y₂O₃ sintering additives on the densification behavior, mechanical and electrical properties of the pressureless-sintered SiC-ZrB2 electroconductive ceramic composites was investigated. The SiC-ZrB₂ electroconductive ceramic composites were pressureless-sintered for 2 hours at 1,700[°C] temperatures with an addition of Al₂O₃+Y₂O₃(6:4 mixture of Al₂O₃ and Y₂O₃) as a sintering aid in the range of $8{\sim}20[\text{wt\%}].$ Phase analysis of SiC-ZrB2 composites by XRD revealed mostly of a-SiC(6H), ZrB2 and In Situ YAG(Al5Y3O12). The relative density, flexural strength, Young's modulus and vicker's hardness showed the highest value of 89.01[%], 81.58[Mpa], 31.437[GPa] and 1.34[GPa] for SiC-ZrB2 composites added with 16 [wt%] Al₂O₃+Y₂O₃ additives at room temperature respectively. Abnormal grain growth takes place during phase transformation from $\beta\text{-SiC}$ into a-SiC was correlated with In Situ YAG phase by reaction between Al₂O₃ and Y₂O₃ additive during sintering. Compositional design and optimization of processing parameters are key factors for controlling and improving the properties of SiC-based electroconductive ceramic composites. In this paper, it is convinced that β -SiC based electroconductive ceramic composites for heaters or ignitors can be manufactured by pressureless sintering.

1.서 론

SiC는 꺾임강도, 경도, 화학적 안정성과 산화, 열충격 저항성등과 같 은 많은 우수한 고온 특성을 지녔지만[1] Si-C 강한 공유결합과 낮은 자기확산 계수때문에 소결조제 없이 높은 소결밀도를 얻을 수 없고, 1000℃이하에서는 전기 저항률이 부(負)저항온도계수이기 때문에 온도 상승과 함께 전류를 억제할 수가 없어 과열이 발생한다.[2-3] 여러 가지 산화물 Al₂O₃, Y₂O₃, CaO 와 질화물인 AlN등의 소결조제를 이용하여 액상 소결(Liquid-Phase-Sintering, LPS)법을 통해 소결 성을 증진 하도 록 미세 구조를 제어한다.[4-5] LPS법은 용해-재응고 과정을 통하여 elongated SiC grain으로 성장되면서 β→α-SiC상 변태가 일어나게 된다. SiC 소결은 소결조제로써 aluminum, boron과 carbon을 사용하여 고 상 소결법으로 제조되기는 하지만 1,950~2,100[℃]의 높은 소결온도를 LPS 법으로 낮출 수 있기 때문에 200~300[℃]이상 계속 떨어뜨릴 수 있는 연구가 계속 수행되고 있다. 천이 금속의 붕화물인 ZrB2는 일반적 으로 3.040[℃]의 고융점, 높은 경도, 우수한 내산화성, 열충격 저항, 열 전도도 및 금속적인 도전성을 지녔지만, 공유결합으로 인한 저 확산계수 로 고온의 소결온도, 오랜 시간이 요구되고 치밀화의 속도가 느리며 낮 은 가공성 등의 부족 점이 문제가 된다. 액상 소결조제는 입자의 경계에 서 물질의 확산을 가속화시키면서, 크랙의 진행과정을 방해하여 파괴인 성과 상대밀도 증진을 가져오기도 하지만 강한 휘발성분으로 인한 저 밀도 때문에 경도, 꺾임강도 등의 기계적 특성에 악영향을 미치는 경우 가 발생한다.

더 나아가 SiC를 기저로 한 ZrB₂ 또는 붕화물 금속의 복합체는 SiC에 비하여 적절한 저항값, 正(+)저항 온도계수, 꺾임강도가 크고 약 1,200 [℃]까지의 내 산화성이 좋기때문에 발열체 또는 점화기 제품에 이용될 가능성이 높다. 순수 ZrB₂ 단일 체는 1,200[℃]이상에서 B₂O₃의 강한 휘 발성에 기인하여 산화가 실제 일어나지만 SiC를 첨가하면 붕 규산염 유 리가 외부 표면에 형성되고 계면의 산화 반응을 향한 시편 내부로의 침 투를 저지하기 되어 훨씬 더 효과적인 산화 저항이 나타나기 때문에 1,500[℃]까지도 안전한 내 산화 특성을 갖게 된다.

본 연구에서는 상압 소결 법으로 액상 소결조제 Al₂O₃+Y₂O₃의 첨가량 에 따라 제조한 SiC-ZrB₂ 도전성 복합체의 기계적, 전기적 특성을 평가 할 목적으로 상대밀도, X-ray 상 분석, 꺾임강도, vicker's 경도, SEM을 조사하였다. 이에 따른 최적 설계요소와 제조기법을 찾고 고온 가압 소 결 법에 비해 제조단가가 낮으며 대량생산 시스템인 상압 소결가능성을 진단하였다.

2. 실험 방법

2.1 출발 원료 및 혼합

출발원료는 61[vol.%]의 β-SiC에 39[vol.%]의 ZrB₂를 혼합하고, 이 혼 합물에 8, 12, 16, 20[wt%]의 Al₂O₃+Y₂O₃(6 : 4 mixture of Al₂O₃ and Y₂O₃)을 첨가하였다. 이렇게 준비된 분말을 아세톤과 SiC ball을 이용하 여 잘 혼합시킨 후 80[℃]에서 6시간동안 건조시켰다. 건조된 시료는 60 mesh 망체로 sieve를 하였다. sieve된 분말을 상대 밀도의 50[%]까지 일축 가압하여 disc모양의 greed body를 성형하였다.

2.2 소결

β-SiC+39[vol.%]ZrB₂에 Al₂O₃+Y₂O₃를 8, 12, 16, 20[wt%]씩 각각 혼 합하여 일축 가압된 성형 체를 흑연 몰드에 넣고 argon gas 분위기에서 소결시켰다. 소결방법은 그림 1에 나타난 바와 같이 700[℃]까지 분당 5.11[℃]로 승온하고 1시간 동안 burnt out한 후 1,700[℃]까지 분당 5 [℃]로 승온하여 2시간 동안 ZrB₂ grain성장과 β-SiC를 elongated grain 으로 변형시키기 위하여 annealing한 후 분당 600[℃]까지 5[℃]로 냉각 시키고 그 이후로는 자연 냉각 시켰다.



<그림 1> 시편제조를 위한 승 온 및 냉각 프로그램

2.3 물성 측정

β-SiC+39[vol.%]ZrB₂에 소결조제 Al₂O₃+Y₂O₃을 8, 12, 16, 20[wt%]씩 첨가한 전도성 세라믹 복합체의 이론밀도는 rule of mixture에 의해서 구해졌고, 상대밀도는 증류수를 이용한 Archimedes 법으로 소결조제의 첨가량에 따른 각각의 세 개의 시편을 취하여 각 sample당 10회 측정한 값의 평균값을 취하였다. 소결시편의 상분석은 꺾임강도 측정이 끝난 각 시편의 파단면을 XRD(PW1700 system, Philips, U.S.A.)를 이용하여 분 석하였다. 꺾임강도 측정용 시편크기는 3×4×25[m³]로서 표면을 10[µm]의 diamond paste로 최종 연마 후 재료시험기(Instron, Model 4204, USA) 를 이용하여 cross head speed 0.5[mm/min]의 조건으로 곡강도 시험법 (JIS R 1601)에 의해 3점 곡강도를 각 시편 당 3회 측정하였다. 정법 (JIS R 1601)에 의해 3점 곡강도를 각 시편 당 3회 측정하였다. 정비 커스 미소경도시험기(Matsuzawa, Model DVK-2, Japan)를 이용하여 경 도 시험법인 압인법(Indentation Method)으로 측정하였다. 시편에 가한 하중은 20[kgf], load speed 40[µm/sec], 유지시간은 10초로 하였으며, 각 시편 당 5회 측정하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1 상 분석 및 미세구조

Al₂O₃+Y₂O₃의 첨가량은 SiC와의 반응으로 인해 생성되는 Al₂O, YO, SiO, CO등의 휘발성 성분이 기공형성을 초래할 수 있고 입계상의 *In* situ YAG(Al₅Y₃O₁₂)상이 형성될 수도 있다. 이중 가장 많은 휘발성 성 분은 Alo고 annealing에 따라서 유리상과 *In situ* YAG상을 용용 시킨 다. SiO₂는 SiC에 항상 포함되어 있기 때문에, 액상선과 공정선은 Al₂O₃-Y₂O₃-SiO₂ 상평형도에 따라서 변하며 치밀 화와 최종 미세구조에 영향을 미친다. 상대밀도는 소결조제 Al₂O₃+Y₂O₃의 첨가량에 따라 각각 세 개의 시편을 취하여 sample당 10회 실험한 측정값의 평균을 그림 2 에 나타내었다. 상압 소결시 고상 소결 온도보다 상대적으로 200~300 [℃] 낮은 온도의 LPS 법이 적용되므로 가장 취약하게 나타나는 많은 porosity를 *In Situ* YAG상으로 충진 되게 하여 밀도 증진을 이루고자 하였다. 액상 소결 조제 Al₂O₃+Y₂O₃의 첨가량이 16[wt%]와 20[wt%] 일 경우 *In Situ* YAG상의 peak intensity가 X선 회절분석 결과와 비슷하 게 나타나지만 상대 밀도는 16[wt%]일 경우 20[wt%]의 값보다 3.57[%] 더 높은 89.01[%]로 가장 높게 나타나고 있다. 이것은 20[wt%]일 연해 상성되는 Al₂O₃+Y₂O₃의 과다 첨가로 SiC와 Al₂O₃간의 반응으로 인해 생성되는 Al₂O, SiO, CO등의 volatile components에 따른 시편 내부에서 의 porosity가 *In Situ* YAG상의 생성보다 더 우선되었기 때문이다.



3.2 꺾임강도

그림 3은 각 시편 당 3회씩 3점 곡 강도 시험법(JIS R1601)으로 실온 에서 측정하여 꺾임 강도의 최고, 최저 및 평균값을 나타낸 것인데 소결 조제 Al₂O₃+Y₂O₃의 첨가량이 8[wt%]일 때 54.08[MPa]로 가장 낮게 나 타나고, 16[wt%]일 때 20[wt%]일 때의 71.48[MPa]보다 10.10[MPa] 높 은 81.58[MPa]로 가장 높게 나타나고 있다. 이는 소결과정 중 carbon의 oxygen에 대한 높은 친화력으로 인한 SiC와 Al₂O₃간의 반응으로 인해 생성되는 Al₂O, SiO, CO등의 volatile components가 시편 내부에서 기공 으로 존재하는 양이 16[wt%]일 때 가장 낮게 나타나고 있기 때문이다.



3.3 Young's modulus 및 vicker's 경도

그림 4에 나타난 바와 같이 실온에서의 Young's modulus 23.213~ 31.437Gpa은 SiC, ZrB₂ 기공 없는 단일상의 값 410~440Gpa, 440~ 539Gpa 보다는 낮게 나타나고 있다. Young's modulus E는 같은 기공 을 갖더라도 제 2차상 과 관계가 있고 amorphous 유리상들의 영향을 받는다. 소결조제 Al₂O₃+Y₂O₃의 첨가량이 8[wt%]일 때 23.213[MPa]로 가장 낮게 나타나고, 16[wt%]일 때 20[wt%]일 때의 26.731[MPa]보다 4.706[MPa] 높은 31.437[MPa]로 가장 높게 나타나고 있다. 이것은 16[wt%]일 경우가 *In Situ* YAG상의 양이 가장 많이 나타나며 volatile components 와 유리상이 가장 적게 나타난 것으로 생각된다. Gibson과 Ashby 방정식 E = E_D(1-P² (여기서 E_D는 기공이 없는 시편의 Young's modulus이고, P는 체적기공률) 또는 단일 상의 E = Eo exp(-bp) (여기서 Eo는 기공이 없는 단일상의 Young's modulus이고, b는 기공의 형태와 겹침에 따른 상수, p는 체적 기공률)의 식에도 관계가 있음을 알 수 있 다.

그림 5은 실온에서 Vicker's 압인법으로 측정하여 경도의 최고, 최저 및 평균값을 나타낸 것인데 소결조제 Al₂O₃+Y₂O₃의 첨가량이 8[wt%]일

때 0.66[GPa]로 가장 낮게 나타나고, 16[wt%]일 때 20[wt%]일 때의 1.16[GPa]보다 0.18[GPa] 높은 1.34[GPa]로 가장 높게 나타나고 있다. 이 것은 상대 밀도와 같은 경향이고 똑같은 물성패턴으로 해석된다.



3. 결 론

액상 소결조제 Al₂O₃+Y₂O₃의 첨가량을 8, 12, 16, 20[wt%]로 변화시켜 1,700[℃]에서 상압 소결한 도전성 β-SiC-ZrB₂ 복합체의 특성을 연구 조사한 결과는 다음과 같다.

1) β-SiC와 ZrB₂의 반응은 나타나지 않고 α-SiC(6H) 과 *In Situ* YAG(A₁₅Y₃O₁₂)상이 나타나고 있다. 소결조제 Al₂O₃+Y₂O₃의 첨가량이 16[wt%]일 때의 상대밀도가 89.01[%]로 가장 높게 나타내고 있다.

2) 소결조제 Al₂O₃+Y₂O₃의 첨가량이 16[wt%]일 때 꺾임강도, Young's modulus와 vicker's 경도가 각각 81.58[MPa], 31.437[MPa]와 1.34[GPa] 로 가장 높게 나타나고 있다.

3) 소결조제 Al₂O₃+Y₂O₃의 첨가량이 16[wt%]까지 증가 할수록 소결 과정 중 SiC와 Al₂O₃간의 반응으로 인해 생성되는 Al₂O, SiO, CO등의 volatile components에 따른 시편 내부에서의 porosity보다 더 *In Situ* YAG상이 생성이 우선되기 때문에 16[wt%]의 제 특성이 가장 높게 나 타나지만 첨가량이 20[wt%]가 되면 과다 첨가로 시편 내부에서의 porosity가 *In Situ* YAG상의 생성보다 우선되어 제 특성이 떨어지게 된 다.

[참 고 문 헌]

- Rong Huang, Hui Gu, Jingxian Zhang and Dongliang Jiang, "Effect of Y₂O₃-Al₂O₃ Ratio on Inter-Granualar Phases and Films in Tape-Casting α-SiC with High Toughness", *Acta Materialia*, 53[8], pp. 2521–2529, 2005.
- [2] Y. D. Shin and J. Y. Ju "Properties and Manufacture of the β -SiC-ZrB₂ Composites Densified by Liquid-Phase Sintering" *Trans. KIEE*. Vol. 48C[2], pp. 92-97, 1999.
- [3] Akira Kondo, "Electrical Conduction Mechanism in Recrystallized SiC", Journal of the Ceramic Society of Japan. Int. Edition, Vol. 100, pp. 1204–1208, 1993.
- [4] S. G. Lee and Y. W. Kim, "Relationship between Microstructure and Fracture Toughness of Toughened Silicon Carbide Ceramics", *J. Am. Ceram. Soc.*, 84[6], pp. 1347–1353, 2001.
- [5] Joe J. Cao, Warren J. Moberlychan, Lutgard C. Dejonghe, Christopher J. Gilbert and Robert O. Ritchie " In Situ Toughened Silicon Carbide Al-B-C Additions", J. Am. Ceram. Soc., 79[2], pp. 461–469, 1996.